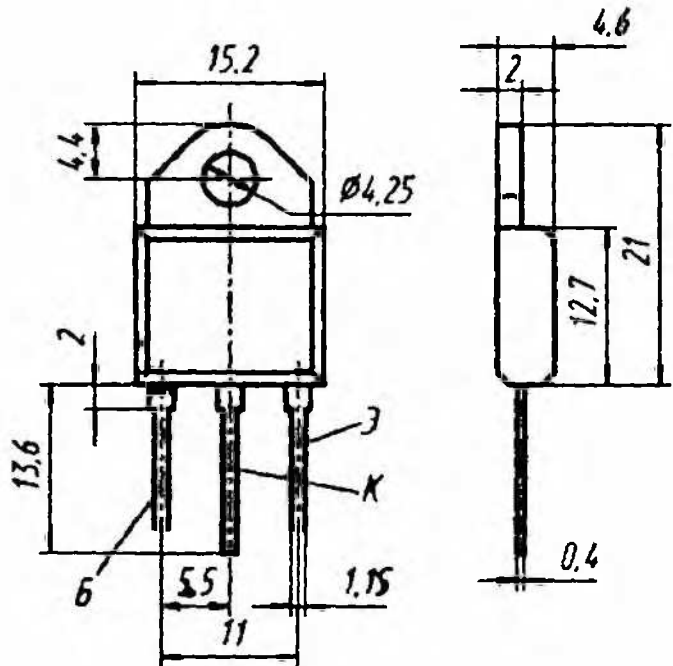


**КТ8127А, КТ8127Б, КТ8127В,  
КТ8127А1, КТ8127Б1, КТ8127В1**

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* переключаемые. Предназначены для применения в схемах строчной развертки и в источниках электропитания. Транзисторы КТ8127А—КТ8127В выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами, КТ8127А1—КТ8127В1 — в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

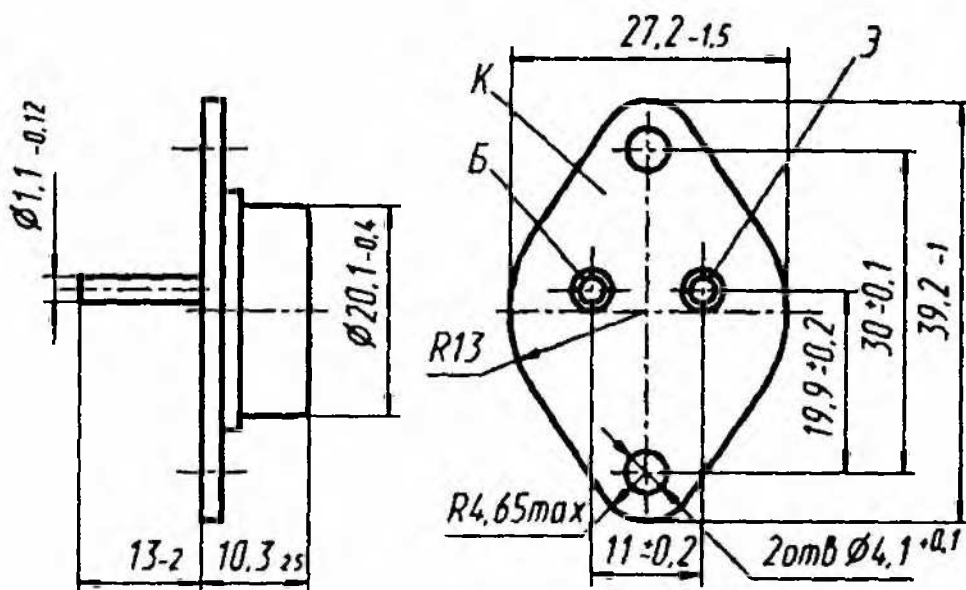
КТ8127(А1-В1)



Масса транзистора в металлическом корпусе не более 20 г, в пластмассовом — не более 10 г.

Изготовитель — ОКБ «ЭлП» ПО «Электронприбор», г. Фрязино, Московская область

КТ8127(А-В)



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока	
в схеме ОЭ при $U_{кз} = 5$ В:	
$I_k = 0,5$ А, не более.....	35
$I_k = 0,03$ А для КТ8127Б1, КТ8127В1, не менее.....	6
Граничное напряжение при $I_k = 0,1$ А, $L = 40$ мГн, не менее.....	
	700 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер, не более:	
$T_k = +25$ °С при $I_k = 4,5$ А, $I_B = 2$ А:	
КТ8127А, КТ8127А1.....	1 В
КТ8127Б, КТ8127Б1.....	5 В
КТ8127В, КТ8127В1.....	5 В
$T_k = +100$ °С при $I_k = 4,5$ А, $I_B = 3$ А:	
КТ8127А, КТ8127А1.....	2,5 В
КТ8127Б, КТ8127Б1.....	5 В
КТ8127В, КТ8127В1.....	5 В
$T_k = -45$ °С при $I_k = 4,5$ А, $I_B = 3$ А:	
КТ8127А, КТ8127А1.....	1,5 В
КТ8127Б, КТ8127Б1.....	5 В
КТ8127В, КТ8127В1.....	5 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 4,5$ А, $I_B = 2$ А, не более.....	
	1,5 В
Постоянное напряжение эмиттер—база, не более:	
при $I_k = 0$ , $I_B = 0,01$ А.....	5 В
при $I_k = 0$ , $I_B = 0,1$ А.....	7 В
Время спада при $U_{кз} = 500$ В, $U_{бэ} = -5$ В, $I_k = 4,5$ А, $I_B = 1,4$ А, $t_{и} = 40$ мкс, не более ....	
типичное значение.....	1 мкс 0,7* мкс
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{кз} = U_{кз, макс}$ , не более:	
$T_k = +25$ и $-45$ °С:	
КТ8127А, КТ8127В, КТ8127А1, КТ8127В1.....	0,9 мА
КТ8127Б, КТ8127Б1.....	0,6 мА
$T_k = +100$ °С:	
КТ8127А, КТ8127В, КТ8127А1, КТ8127В1.....	2 мА
КТ8127Б, КТ8127Б1.....	1 мА

## Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор—эмиттер  
при  $R_{БЭ} = 100 \text{ Ом}$ ,  $t_{и} = 20 \text{ мкс}$ ,  $t_{ф} = 2 \text{ мкс}$ ,  
 $Q = 4$ :

КТ8127А, КТ8127В, КТ8127А1, КТ8127В1	1500 В
КТ8127Б, КТ8127Б1 .....	1200 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	5 В
Постоянный ток коллектора .....	5 А
Импульсный ток коллектора .....	7,5 А
Импульсный ток базы .....	4 А
Постоянный запирающий ток базы .....	0,1 А
Импульсный запирающий ток базы .....	3,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора <sup>1</sup> при $T_{к} = -45...+32 \text{ }^{\circ}\text{С}$ .....	56 Вт
Температура $p$ - $n$ перехода .....	+115 $^{\circ}\text{С}$
Тепловое сопротивление переход—корпус при $U_{кэ} = 15 \text{ В}$ , $I_{к} = 0,78 \text{ А}$ .....	1,6 $^{\circ}\text{С}/\text{Вт}$
Температура окружающей среды .....	-45... $T_{к} =$ = +100 $^{\circ}\text{С}$

---

<sup>1</sup> При  $T_{к} > +32 \text{ }^{\circ}\text{С}$  максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{к, \text{ макс}} = (T_{п} - T_{к}) / R_{т (п-к)}, \text{ Вт.}$$